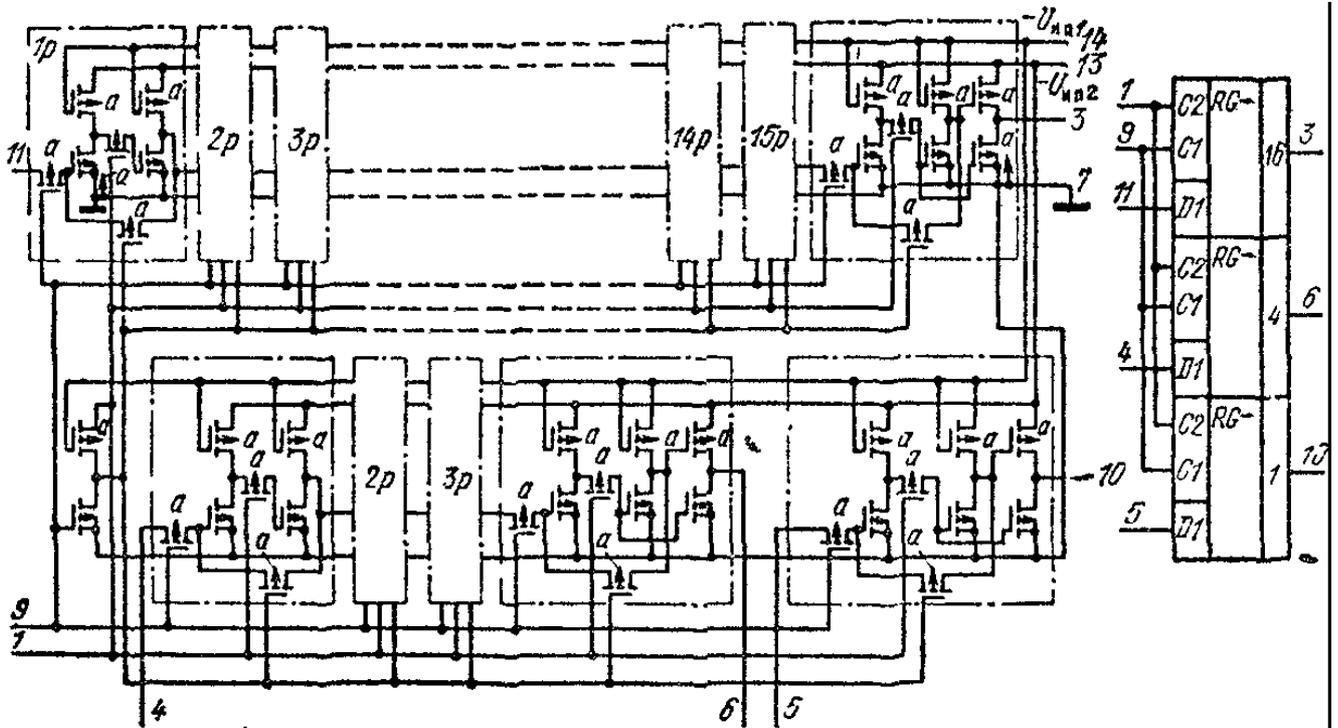


# К1ИР441, К144ИР1, К144ИР1П

Квазистатический последовательный регистр сдвига на 21 разряд, состоящий из трех регистров с числом разрядов 1, 4, 16 с отдельными входами, с общими цепями сдвига и питания.

Корпус: круглый металлокерамический 301.12-1 (К144ИР1, К1ИР441), прямоугольный пластмассовый 201.14-1 (К144ИР1П).



## Электрические параметры

Напряжение источника питания:

$U_{ип1}$	$-27 \text{ В} \pm 10\%$
$U_{ип2}$	$-12,6 \text{ В} \pm 10\%$

Задержка выходного сигнала относительно входного на частоте 750 кГц

21 (16,4,1) бит

Выходное напряжение:

$U_{вых}^0$	не менее $-1 \text{ В}$
$U_{вых}^1$	не более $-9 \text{ В}$

Входной ток:

$I_{вх}$	не более 1 мкА (не более 5 мкА)*
$I_{вх \phi_1}$	не более 15 мкА (не более 100 мкА)*
$I_{вх \phi_2}$	не более 400 мкА (не более 500 мкА)*

Ток потребления:

$I_{пот1}$	не более 2,2 мА (2,5 мА)*
$I_{пот2}$	не более 4,4 мА

Выходное сопротивление

при $U_{вых} = -1 \text{ В}$	не более 5 кОм
при $U_{вых} = -9,5 \text{ В}$	не более 10 кОм

Время перехода из состояния «0» в состояние «1»

не более 950 нс

Время перехода из состояния «1» в состояние «0»

не более 950 нс

Минимальное время ввода информации

100 нс

Помехоустойчивость статическая

не более 1 В

Режим измерения микросхемы следующий:  $T = -45...+70^\circ\text{C}$ ;  $U_{ип1} = -24,3...-29,7 \text{ В}$ ;  $U_{ип2} = -11,34...-13,86 \text{ В}$ .

\* по некоторым источникам

## Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Напряжение источника питания:	
$U_{ип1}$	-27 В±10%
$U_{ип2}$	—12,6 В±10%
Напряжение:	
$U^0_{ф1}$	0...-2,5 В
$U^1_{ф2}$	—24,3...—29,7 В
Напряжение:	
$U^0_{и\text{ вх}}$	0...-2 В (0...-3 В)*
$U^1_{и\text{ вх}}$	-24,3...-29,7 В (-22...-28 В)*
Минимальное входное напряжение «1»	—8,5 В
Напряжение статической помехи по информационным входам	не менее —1 В
Частота импульсов фаз	0...750 кГц (0...1 МГц)*
Длительность импульсов:	
$T_{и\text{ ф1}}$	не менее 0,38 мкс (0,2...10 мкс)*
$T_{и\text{ ф2}}$	не менее 0,65 мкс (0,5...20 мкс)*
Время хранения информации по фазе Ф2	не более 50 мкс
Время задержки импульса фазы Ф2	не более 30 мкс
Сопротивление нагрузки	не менее 1 МОм (не менее 0,5 МОм)*
Емкость нагрузки	не более 20 пФ (не более 50 пФ)*
Емкость информационных входов	не более 4 пФ (не более 3 пФ)*
Емкость входов фаз Ф1, Ф2	не более 15 пФ (не более 7 пФ)*
Потребляемая мощность	не более 150 мВт
* по некоторым источникам	

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	от -10 до +70°C
Многократное циклическое изменение температуры	от -10 до +70°C
Относительная влажность воздуха при +20°C	до 98%
Вибрационные нагрузки	до 5 g (5-600 Гц)
Многократные удары с ускорением	до 15 g
Линейные нагрузки с ускорением	до 25 g